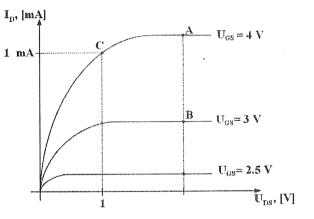
ZADATAK 1. Silicijska dioda sa skokovitim pn-spojem ima koncentracije primjesa $N_D=10^{16}\,cm^{-3}$ i $N_A=8\cdot 10^{15}\,cm^{-3}$. Vrijedi da je $W_p\ll L_n$ i $W_n=3\,\mu m\ll L_p$. Površina pn spoja iznosi $S=0,5\,mm^2$. Pokretljivosti manjinskih nosilaca su 1100 cm²/Vs i 200cm²/Vs, a vremena života $\tau_n=0,8\,\mu s$ i $\tau_p=0,5\,\mu s$. Pri naponu propusne polarizacije $U_D=0,5\,V$ nakrcani naboj manjinskih elektrona je $Q_n=0,78\,pAs$. Temperatura je 300 K, a m=1.

- a) Nacrtati raspodjele manjinskih nosilaca, izračunati i označiti rubne te ravnotežne koncentracije za priključeni napon U_D =0,5V (4 boda).
- b) Odrediti iznos struje kroz diodu uz U_D =0,5 V (2 boda)
- c) Odrediti vrijeme proleta manjinskih elektrona i šupljina t_n i t_p (2 boda).
- d) Odrediti dinamički otpor diode uz $U_D = 0.5V$ i $U_D = -0.5V$ (2 boda).

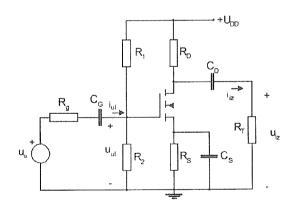
ZADATAK 2. Izlazna karakteristika nekog MOSFET-a prikazana je na slici. Za struje u točkama A i B vrijedi $I_{DA} = 4 \cdot I_{DB}$. Faktor modulacije dužine kanala λ približno je jednak nuli.

- (d) Uz obrazloženje, odrediti tip MOSFET-a (*n* ili *p* kanalni, obogaćeni ili osiromašeni) (**1 bod**).
- (b) Izračunati napon praga U_{GS0} (2 boda).
- C) Odrediti struju odvoda u točki A (2 boda).
- (d) Odrediti dinamički parametar g_m u točkama A i C (2 boda).
- e) Nacrtati prijenosnu karakteristiku i na njoj označiti položaj točaka A, B i C (3 boda).



ZADATAK 3. Za pojačalo na slici zadano je: $U_{DD} = 15 \text{ V}$, $R_{\rm g} = 500 \Omega$, $R_1 = 2 \text{ M}\Omega$, $R_2 = 1 \text{ M}\Omega$, $R_S = 2.2 \text{ k}\Omega$, $R_D = 1.2 \text{ k}\Omega$, i $R_T = 5.6 \text{ k}\Omega$. Parametri n-kanalnog MOSFET-a su: $K = 4 \text{ mA/V}^2$, $U_{GSO} = 1 \text{ V}$ i $\lambda = 0.004 \text{ V}^{-1}$. Napon generatora iznosi $u_G = 100 \text{ [mV]} + 10 \sin(\omega t) \text{ [mV]}$. Pretpostaviti C_G , C_S i $C_D \rightarrow \infty$.

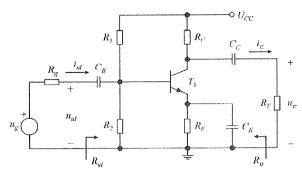
- a) Odrediti statičku radnu točku tranzistora (I_{DQ} , U_{DSQ} , U_{GSQ}) te strminu i dinamički otpor u radnoj točki. Pri proračunu statičke radne točke zanemariti porast struje odvoda u području zasićenja (**3 boda**).
- Skicirati nadomjesnu shemu pojačala za dinamičku analizu (1 bod).



- c) Odrediti izmjeničnu komponentu ulaznog napona u_{ul} i struje i_{ul} (2 boda).
- d) Odrediti izmjeničnu komponentu izlaznog napona u_{iz} i struje i_{iz} (2 boda).
- e) Na istom grafu skicirati napon generatora u_{G_1} ulazni napon u_{ul} i izlazni napon u_{iz} (2 boda).

ZADATAK 4. Za pojačalo na slici zadani su sljedeći podaci: $R_I = 10 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 5,6 \text{ k}\Omega$, $R_C = 1 \text{ k}\Omega$, $R_E = 2 \text{ k}\Omega$, $R_T = 1 \text{ k}\Omega$, $R_g = 50 \Omega$ i $U_{CC} = 15$ V. Parametri npn tranzistora su $\beta \approx hfe = 120$, $U_{\gamma} = 0,7$ V. Naponski ekvivalent temperature iznosi $U_T = 25$ mV. Utjecaji serijskog otpora baze i izlaznog dinamičkog otpora tranzistora mogu se zanemariti.

- a) Odrediti statičku radnu točku (U_{CEQ} , I_{CQ}), strminu i ulazni dinamički otpor u statičkoj radnoj točki (2 boda).
- Skicirati statički i dinamički radni pravac, označiti osi i karakteristične točke na osima, te odrediti maksimalni hod izlazne struje i_{iz} (3 boda).



c) Nacrtati nadomjesnu shemu za dinamičku analizu, izvesti izraze i izračunati iznose naponskih pojačanja $A_V = u_{iz}/u_{ul}$ i $A_{Vg} = u_{iz}/u_g$, strujnog pojačanja $A_I = i_{iz}/i_{ul}$, ulaznog otpora R_{ul} , te izlaznog otpora R_{iz} (5 bodova).

ZADATAK 5. Na slici je prikazan sklop s idealnim operacijskim pojačalima. Vrijednosti otpornika su: $R_1 = 1.8$ kΩ, $R_2 = 3.6$ kΩ, $R_3 = 2.7$ kΩ, $R_4 = 5.4$ kΩ, $R_5 = 56$ kΩ i $R_6 = 56$ kΩ. Maksimalni iznos izlaznog napona je $U_{IZ2max} = 5$ V, a minimalni iznos je $U_{IZ2min} = -5$ V.

- (a) Odrediti ovisnost napona u_{1Z1} o ulaznim naponima u_1 i u_2 (7 bodova).
- (b) Odrediti iznos izlaznog napona u_{122} uz zadane napone $u_1 = 0.5$ V i $u_2 = 2$ V (3 boda).

